

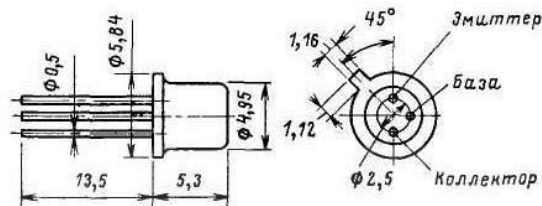
# КТ343А, КТ343Б, КТ343В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *p-n-p* универсальные высокочастотные маломощные.

Предназначены для работы в переключающих, импульсных и усилительных схемах высокой и низкой частот, генераторах низкой и высокой частот.

Выпускаются в металlostеклянном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе

Масса транзистора не более 0,5 г



## Электрические параметры

|                                                                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 10$ мА, $I_B = 1$ мА не более . . . . .                    | 0,3 В   |
| Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 0,3$ В, $I_3 = 10$ мА не менее |         |
| КТ343А, КТ343В . . . . .                                                                                     | 30      |
| КТ343Б . . . . .                                                                                             | 50      |
| Модуль коэффициента передачи тока при $f = 100$ МГц, $U_{КБ} = 5$ В $I_3 = 10$ мА не менее . . . . .         | 3       |
| Время рассасывания при $I_K = 10$ мА, $I_B = 1$ мА не более                                                  |         |
| КТ343А, КТ343В . . . . .                                                                                     | 10 нс   |
| КТ343Б . . . . .                                                                                             | 20 нс   |
| Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В, $f = 10$ МГц не более . . . . .                           | 6 пФ    |
| Емкость эмиттерного перехода при $U_{БЭ} = 0$ В, $f = 10$ МГц не более . . . . .                             | 8 пФ    |
| Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 10$ В КТ343А, КТ343Б и при $U_{КБ} = 7$ В КТ343В не более . . . . .    | 1 мкА   |
| Обратный ток коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} = 10$ кОм, $U_{КЭ} = U_{КЭ\text{ макс}}$ не более . . . . .       | 100 мкА |

## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при

$R_{БЭ} \leq 10$  кОм

КТ343А КТ343Б . . . . . 17 В

КТ343В . . . . . 9 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при  $I_{БЭ} =$

$= 100$  мкА . . . . . 4 В

Постоянный ток коллектора . . . . . 50 мА

Импульсный ток коллектора при  $\tau_n \leq 10$  мкс,

$Q \geq 500$  . . . . . 150 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при

$T = 233 - 348$  К . . . . . 150 мВт

Температура перехода . . . . . 423 К

Температура окружающей среды . . . . . От 233 до 358 К

Примечания 1 Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, мВт, при  $T = 348 - 358$  К рассчитывается по формуле

$$P_{К\text{ макс}} = (423 - T)/0,5$$

2 Допускается производить пайку на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора Разрешается производить пайку путем погружения выводов не более чем на 3 с в расплавленный припой с температурой 533 К

Минимальное расстояние места изгиба вывода от корпуса транзистора не менее 3 мм, радиус изгиба не менее 1,5 мм

При включении транзистора в электрическую цепь, находящуюся под напряжением, коллекторный вывод должен присоединяться последним и отсоединяться первым Не рекомендуется эксплуатация транзисторов с отключенной по постоянному току базой Не рекомендуется эксплуатация транзисторов при рабочих токах, соизмеримых с неуправляемыми обратными токами во всем диапазоне температур